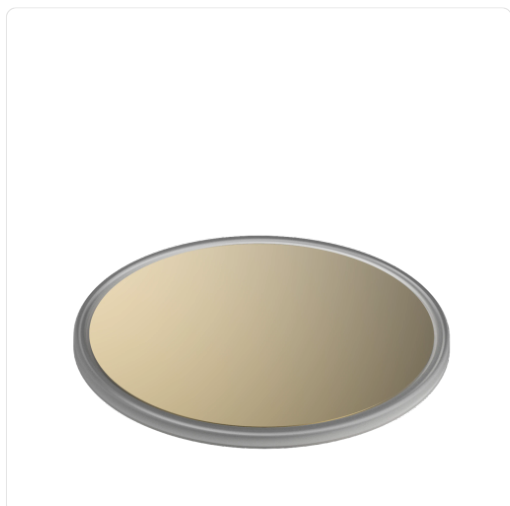


Германиевые подложки (e)



Технические характеристики

Диаметр, мм	100
Толщина, мкм	175
Отклонение от номинала, мкм	± 25
Кристаллографическая ориентация, °	(100)+6°; (111)
Тип проводимости	P
Легирующая примесь	Ga
Удельное сопротивление	0.01–0.04 Ом·см
Концентрация носителей заряда, см-3	От 1·10 ¹⁸ до 4·10 ¹⁸
Плотность дислокаций, см-2	< 500
Ориентационный срез в направлении	(100)
Полировка	Односторонняя
TTV минимум, мкм	—
TTV стандарт, мкм	до 15